|  |  |
| --- | --- |
| 文章标题 | 静态漏源导通电阻仅为0.42Ω，一款面向继电器驱动的MOS管 |
| 市场/应用 | 电源转换器电路，继电器驱动，高速脉冲放大器 |
| 关键词 | VDSS, 导通电阻, 漏极/源极电压, 耗散功率, 电荷量, Id |
| 摘要 | P8B30HP2是新电元（ShinDengen）公司推出的一款针对工业化应用的N沟道金属氧化物半导体场效应管，具有高电压、低导通电阻、高雪崩耐久性、高di/dt耐久性的特点。可应用于电源转换器电路，继电器驱动，高速脉冲放大器等应用。 |

P8B30HP2是新电元（ShinDengen）公司推出的一款针对工业化应用的N沟道金属氧化物半导体场效应管，相比于P沟道MOS管，拥有更小的导通电阻。最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为300.0V，最大漏极持续电流（DC）Id为8.0A，所用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造而成，拥有更好的包封和阻燃性能。具有高电压、低导通电阻、高雪崩耐久性、高di/dt耐久性的特点。可应用于电源转换器电路，继电器驱动，高速脉冲放大器等应用。

采用SMD（Surface Mounted Devices）表面贴装，以Sn为主要材料，大多采用内箱直径为180mm的Tape & Reel带卷式封装。具体封装形态为FB，是一款具体尺寸为10.0mm（W）X6.6mm（H）X2.3mm（D）mm，适用于小型嵌入式电器设计。

图1 P8B30HP2外部视图

P8B30HP2的最大栅极/源极电压VGSS为±30V，最大耗散功率Pd为54.0W，提高了能源利用效率，同时保障了MOSFET在高功率场合下的可靠性和稳定性。其静态漏源导通电阻Rds典型值为0.42Ω，最高沟道温度Tch为150.0℃，总栅极电荷量典型值Qg为10.0 nC。

图2 P8B30HP2典型输出特性及转移特性曲线

P8B30HP2的主要特点：

• 最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为300.0V，最大栅极/源极电压VGSS为±30V

• 最大漏极持续电流（DC）Id为8.0A，最大耗散功率Pd为54.0W

• 静态漏源导通电阻Rds典型值为0.42Ω

• 最高沟道温度Tch为150.0℃

• 总栅极电荷量典型值Qg为10.0 nC

• 采用FB封装, 尺寸大小为10.0mm（W）X6.6mm（H）X2.3mm（D）

P8B30HP2的典型应用：

• 电源转换器电路

• 继电器驱动

• 高速脉冲放大器